Fubon Global Equity Division
2026 年 10 月 22 日

Lam Research Corporation (LRCX)

公司簡介

公司主要販售半導體製造商適用的設備儀器，同時提供相關解決方案，輔助客戶生產半導體。旗下產品可應用於非揮發性記憶體(NVM)、微機電系統(MEMS)，與動態隨機存取記憶體(DRAM)等，電子、邏輯裝置的生產作業。旗下業務可依據性質分為兩大類，分別為：1)設備：販售可進行半導體沉積、蝕刻，以及清洗作業的設備儀器；2)客戶相關服務：提供客戶售後服務，如設備升級，和備用零件販售等。主要客戶為半導體記憶體、代工廠和整合設備製造商，包括英特爾、鎧俠、美光科技、三星電子、台積電等知名企業。

基本資訊

收盤價	$260.81
產業別	半導體材料及設備
市值 (百萬)	$326,383.99
流通在外股數 (百萬)	1,251
過去1年股價區間	$135.50 - $438.50

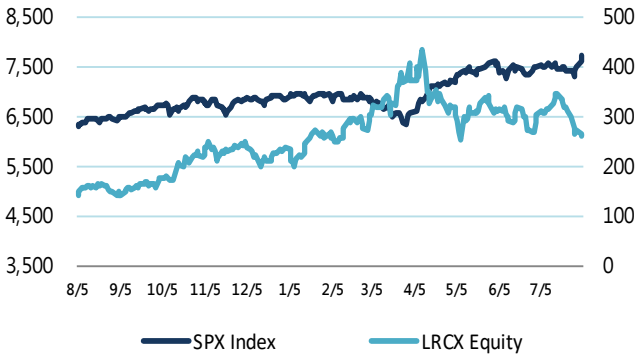
分析師預估

12個月目標價	$379.10
評等	
買進	31
持有	6
賣出	0

股價表現

5日股價漲跌幅	-9.1
近1月股價漲跌幅	-13.7
近3月股價漲跌幅	-19.0
近12月股價漲跌幅	79.8
YTD	52.4

近期股價走勢



季損益表	F1Q27A	F2Q27F	F3Q27F	F4Q27F
營收	8,219	8,595	8,849	9,273
YoY%	54.38	60.82	51.49	37.94
毛利率	52.30	51.90	52.08	52.28
EBIT	3,301	3,412	3,530	3,732
Net income	2,768	2,905	3,026	3,194
non-GAAP EPS	2.19	2.34	2.43	2.57

年損益表	FY26A	FY27F	FY28F	FY29F
營收	23,233	35,103	41,902	48,099
YoY%	26.02	51.09	19.37	14.79
毛利率	50.60	51.90	52.42	53.19
EBIT	8,320	14,009	17,505	20,476
Net income	7,334	11,939	15,053	17,618
non-GAAP EPS	5.82	9.51	11.93	14.35

免責聲明：本文非研究報告，係由富邦證券法人業務處整理提供，所載資料僅供定客戶參考，不構成要約、招攬、宣傳、誘使等表示，亦無建議或推薦本文提及之任何證券，有關觀點亦未考量個別投資人之投資目標，富邦證券法人業務處不對投資損益負擔任何責任。

座談重點摘要

1. 公司預估 CY26 全球 WFE 約 US$155bn，CY27 將突破 US$200bn，成長動能依序為 DRAM、Foundry Logic 及 NAND。受惠 AI 相關產能擴張及製程複雜度提升，公司預期營收持續優於 WFE 成長。儘管無塵室建置及零組件供應仍為主要瓶頸，隨 2027 年約 10 座大型晶圓廠陸續投產，設備需求可望進一步釋放。
2. NAND 由 128 層升級至 200 層的需求預計延續至 2027 年，後續 300 至 400 層製程轉換將帶動新設備與升級需求。AI 儲存架構朝 SLC NAND 及 HBF 發展，進一步提高晶圓產能需求。此外，DRAM 3D 架構、GAA 及背面供電技術持續增加蝕刻與薄膜沉積製程強度，有利公司擴大每片晶圓可服務市場及設備市占率。
3. 公司維持 CY26 先進封裝業務營收年增約 70%的預期，並看好 CY27 延續成長，面板級封裝設備已出貨逾 20 家客戶。Aether Dry Resist 受惠 HBM 產能擴張及新客戶導入，至 2030 年底累計營收預測上修 US$1bn 至 US$2.5bn。此外，Akara Etch、先進金屬化及表面處理設備持續擴大應用，有利公司提升產品組合及長期獲利能力。

公司近況更新

1. FY1Q27（CY3Q26）營收季增 22%、年增 54%至 US$8.22bn，連續五季創歷史新高，主要受惠於先進製程、記憶體及中國市場設備需求強勁。毛利率季增 0.4 個百分點至 52.4%，營業利益率季增 1.8 個百分點至 40.2%，雙雙創歷史新高，EPS 達 US$2.20。NAND 設備營收季增約 40%，CSBG 營收接近 US$2.5bn，顯示設備銷售及售後服務業務均維持強勁動能。
2. 公司預估 FY2Q27(CY4Q26)營收為 US$8.6bn(±US$400mn)，季增約 5%，毛利率預估 52.5%（±1 個百分點），營業利益率預估 40.5%(±1 個百分點)，EPS 預估 US$2.33(±US$0.15)。儘管部分零組件供應瓶頸限制設備出貨，且中國市場營收占比預期明顯下降，公司仍看好先進製程及記憶體設備需求，受供應限制遞延的訂單預計於 FY3Q27 出貨，支撐後續營收成長。

免責聲明：本文非研究報告，係由富邦證券法人業務處整理提供，所載資料僅供定客戶參考，不構成要約、招攬、宣傳、誘使等表示，亦無建議或推薦本文提及之任何證券，有關觀點亦未考量個別投資人之投資目標，富邦證券法人業務處不對投資損益負擔任何責任。

3. 公司預估 CY27 WFE 將由 CY26 約 US$155bn 成長至超過 US$200bn，成長動能依序為 DRAM、Foundry Logic 及 NAND。隨著先進製程、先進封裝及記憶體設備需求增加，公司預期持續優於 WFE 成長，CSBG 於 CY27 亦可望年增超過 15%。儘管無塵室及供應鏈產能仍構成限制，看好新產品導入、定價優化及製造效率提升，帶動中長期毛利率 55%邁進。

Q&A

Q：供應鏈瓶頸對短期營收及後續出貨的影響？

A： CY4Q26（12 月季度）營收指引為 US$8.6bn，若未受到短期供應鏈限制影響，實際營收指引原本有機會進一步提高，但管理層並未量化供應鏈瓶頸造成的營收遞延金額，因此未確認市場提出的 US$300–400mn 估計。公司強調，目前限制主要來自部分供應鏈零組件供給不足，而非終端客戶需求減弱。由於晶圓製造設備需求持續強勁，部分原本預計於 CY4Q26 出貨的設備將遞延至 CY1Q27(2027 年 3 月季度)，因此相關營收預期將隨出貨時程順延，而非訂單流失。管理層確認，原定於 12 月季度出貨但因供應限制延後的設備，預計於 3 月季度完成出貨。

Q：DRAM 從 $4F^2$ 轉向 3D 架構對公司設備需求的影響？

A：無論 DRAM 製程持續沿用現有平面架構，或加速轉向 3D DRAM，均有利於蝕刻及薄膜沉積設備需求增加，主要原因在於記憶體結構複雜度提升，將同步推升 Etch 與 Deposition Intensity。若 DRAM 製造商延長現有架構的使用時間，為持續提高記憶體密度及效能，晶片製造商必須進一步縮小線寬與圖案尺寸，進而增加先進圖案化技術需求，帶動公司 Akara Conductor Etch 及 Aether Dry Resist 等設備的應用機會。另一方面，若 DRAM 製造商跳過 $4F^2$ 架構，直接由現有 $6F^2$ 架構轉向 3D DRAM，垂直堆疊結構將進一步增加高深寬比蝕刻及薄膜沉積製程需求，使設備製程強度更快提升。管理層強調，3D 架構轉換不會削弱公司的競爭優勢，反而可能使原先預期較晚發生的設備需求提前實現。整體而言，無論 DRAM 客戶選擇延長現有製程架構，或加快

免責聲明：本文非研究報告，係由富邦證券法人業務處整理提供，所載資料僅供定客戶參考，不構成要約、招攬、宣傳、誘使等表示，亦無建議或推薦本文提及之任何證券，有關觀點亦未考量個別投資人之投資目標，富邦證券法人業務處不對投資損益負擔任何責任。

導入 3D DRAM，公司均可受惠於製程複雜度提升，因此管理層對 DRAM 技術演進帶來的長期設備需求保持樂觀。

Q：公司如何解決供應鏈瓶頸？是否考慮共同投資供應商？

A： 公司表示，隨著半導體設備需求快速成長，部分供應商已開始出現產能緊張情況，但目前供應鏈問題的嚴重程度遠低於 COVID-19 疫情期間的供應短缺。公司持續與全球供應商密切合作，並於過去兩個月舉辦多場大型供應商會議，向供應鏈明確說明未來數年的需求成長預期，協助供應商提前規劃產能擴充與資源配置。值得注意的是，由於先進封裝、蝕刻及薄膜沉積製程強度持續提升，部分特定設備與零組件需求的成長速度甚至高於公司整體營收成長率，因此部分供應商面臨更大的擴產壓力。管理層強調，供應鏈管理的核心在於提高需求預測透明度，確保供應商充分掌握未來需求規模，並及早辨識可能影響交期的瓶頸。針對是否提供資本支援，公司表示不排除透過共同投資或其他財務安排協助供應商擴產，但目前多數供應商具備充足資本，原則上能自行負擔必要的擴產支出，因此尚無大規模資本支援計畫。整體而言，管理層預期目前供應鏈緊張情況可在相對短期內逐步改善，並有信心維持良好的供應鏈執行能力。

Q：NAND 升級週期進度及 SLC NAND 的新增需求？

A： 公司表示，目前 NAND 升級週期仍有持續推進空間，原先由 128 層級升級至 200 層級 NAND 的轉換需求預計延續至 2027 年，而隨著記憶體製造商逐步導入 300 層及 400 層級 NAND，後續仍將出現新一輪設備升級需求。值得注意的是，在 NAND 產能利用率維持高檔的情況下，客戶必須暫時停止部分既有設備運作才能進行升級，因此實際轉換速度亦受到產線排程限制。公司認為，NAND 設備需求的驅動因素已不再僅限於堆疊層數增加，而是逐步擴展至 AI 工作負載對不同儲存效能的需求。傳統 NAND 主要透過提高儲存密度降低單位成本，但 AI 應用開始要求不同層級的儲存架構，包括提供高容量儲存的 QLC、支援高頻寬資料存取的 TLC，以

免責聲明：本文非研究報告，係由富邦證券法人業務處整理提供，所載資料僅供定客戶參考，不構成要約、招攬、宣傳、誘使等表示，亦無建議或推薦本文提及之任何證券，有關觀點亦未考量個別投資人之投資目標，富邦證券法人業務處不對投資損益負擔任何責任。

及滿足低延遲、高速存取需求的 SLC Class NAND。由於 SLC 相較 TLC 的單位元件儲存位元數約減少三倍，若部分 NAND 產能轉向 SLC，在相同儲存位元需求下，將需要更多晶圓產能支援。公司估計，每當 NAND 位元需求組合有 1 個百分點轉向 SLC Class NAND，為維持相同位元供給，約需增加 2% 的晶圓產能，若 AI 帶動整體儲存位元需求同步增加，所需新增產能可能進一步擴大。管理層認為，NAND 產業正由單純追求容量密度，逐步轉向依據不同 AI 工作負載優化儲存架構，此趨勢將同時推升新設備採購、既有設備升級及高階蝕刻與沉積製程需求，有利於公司中長期 NAND 設備業務成長。

Q：CY4Q26 設備營收是否包含一次性收入或漲價效益？

A： 公司表示，CY4Q26 營收指引所反映的設備需求主要來自正常客戶訂單及實際半導體產能投資，並未包含特殊的一次性收入或非經常性設備銷售，因此不應將單季設備營收表現直接解讀為一次性因素推升。儘管依據公司 CY4Q26 營收指引推算的設備市場需求可能高於全年 WFE 約 US$155bn 的水準，但管理層強調，12 月季度的強勁表現主要反映客戶持續擴大設備採購，而非特殊收入認列或單次價格調整。公司亦重申，若未受到短期供應鏈瓶頸影響，CY4Q26 營收指引原本有機會進一步提高，顯示目前設備出貨仍受到供給端限制。管理層未針對單季設備收入隱含的 WFE 年化水準進行額外量化，也未將價格調整列為該季度營收成長的特殊驅動因素。

Q：中國市場營收占比於 CY4Q26 的變化？

A： 公司表示，CY3Q26 中國市場營收占比達 35%，高於前一季度的 26%，主要受惠於中國本土半導體製造商及跨國半導體企業同步增加設備採購。管理層強調，中國市場於 CY3Q26 的強勁表現符合公司原先預期，並非超出預期的一次性訂單挹注。然而，隨著中國本土客戶設備採購時程變化，預期 CY4Q26 中國市場營收占比將較 CY3Q26 明顯下降，其中主要調整將來自中國本土半導體製造商，跨國企業於中國的設備投資則預期維持相對強勁。公司並未提供 CY4Q26 中

免責聲明：本文非研究報告，係由富邦證券法人業務處整理提供，所載資料僅供定客戶參考，不構成要約、招攬、宣傳、誘使等表示，亦無建議或推薦本文提及之任何證券，有關觀點亦未考量個別投資人之投資目標，富邦證券法人業務處不對投資損益負擔任何責任。

國市場營收占比的具體數字，但明確指出占比將出現顯著下降。整體而言，中國市場短期營收變動主要反映不同客戶群的設備採購時程與組合變化，並不代表所有中國客戶需求同步轉弱。

Q：CSBG 成長動能及各業務對獲利的貢獻？

A： Customer Support Business Group（CSBG）於 2026 年前九個月營收成長約 36%，全年營收預期年增超過 30%，主要受惠於設備稼動率維持高檔、備品需求增加、NAND 設備升級、成熟製程設備需求回升，以及設備智慧化服務持續擴張。就目前營收規模而言，備品（Spares）仍為 CSBG 最大的單一業務項目，並隨半導體工廠設備利用率提升而持續成長；服務業務同樣受惠於客戶產線高負載運作，NAND 轉換與升級需求則提供額外成長動能。此外，成熟製程設備投資回升亦帶動 Reliant 業務表現改善。管理層特別強調，Equipment Intelligence、Dextro Cobots 及 Performance-based Service Contracts 將成為未來 CSBG 重要的新增成長來源。隨著先進半導體製程持續微縮，晶片製造商對製程穩定性、設備維護精準度及良率控制的要求同步提高，設備智慧化及自動化維護技術可協助客戶降低製程變異，並改善產線營運效率，因此相關服務的客戶採用意願持續增加。公司近期已與多家記憶體製造商簽訂績效導向服務合約，顯示智慧化服務的商業化進展。雖然管理層未揭露各項業務的具體營收占比、成長排名或 CSBG 營業利益率年增幅度，但預期備品、服務、升級及成熟製程相關需求可延續至 2027 年，並看好智慧化服務對長期成長的貢獻。

Q：中國以外成熟製程設備需求是否將回升？

A： 公司表示，隨著先進製程產能持續吃緊，部分成熟及特殊製程市場，包括類比 IC、功率半導體、微控制器及其他成熟製程產品，亦開始出現產能供給緊張的情況，進而帶動晶圓代工廠及 IDM 評估新增產能投資。公司已觀察到成熟製程相關需求改善，並反映於 Reliant 設備業務表現，但若排除中國市場，管理層預期 2026 年成熟製程設備投資尚不至於出現顯著成長，主要成

免責聲明：本文非研究報告，係由富邦證券法人業務處整理提供，所載資料僅供定客戶參考，不構成要約、招攬、宣傳、誘使等表示，亦無建議或推薦本文提及之任何證券，有關觀點亦未考量個別投資人之投資目標，富邦證券法人業務處不對投資損益負擔任何責任。

長機會預計於 2027 年逐步浮現。管理層認為，隨著中國以外的成熟製程產能供需逐漸趨緊，相關晶圓製造商將增加設備採購與產能擴充，因此預期 2027 年中國以外成熟製程設備支出將明顯轉強。整體而言，成熟製程需求改善已開始反映於部分設備訂單，但實質成長貢獻預計以 2027 年較為明顯。

Q：2027 年公司能否持續優於 WFE 成長？

A： 公司對 2027 年持續優於整體 WFE 市場成長保持正面看法，主要驅動因素為半導體製程複雜度持續提升，帶動蝕刻與薄膜沉積設備於整體晶圓製造流程中的使用強度增加。管理層指出，先進封裝為公司具備高度競爭優勢的領域，隨著 AI 晶片逐步採用更複雜的封裝架構，相關蝕刻及沉積設備需求預期持續增加，且成長機會正由傳統晶圓級封裝進一步延伸至面板級封裝。記憶體方面，NAND 堆疊層數增加、SLC Class NAND 等新型儲存架構出現，以及 DRAM 技術演進，均有利於提高製程強度；先進邏輯方面，公司過去四至五年持續投資 Foundry Logic 及 DRAM 相關新產品，目前已開始反映於營收成長，並成為公司在相關市場取得份額的重要基礎。管理層特別強調，NAND 市場尚未完全釋放長期成長潛力，隨著 AI 儲存需求增加，未來仍有進一步擴張空間。公司過去提出每 US$100bn AI CapEx 約可帶動 US$10bn WFE 需求的概念，而隨著半導體製程結構演進，預期 2027 年公司在相同 WFE 支出中的可服務市場機會將高於 2026 年。整體而言，公司認為設備成長不僅取決於晶圓產能擴張，更受到單位晶圓製程強度提升所驅動，因此即使不同終端市場成長速度存在差異，仍有機會透過產品組合優化及製程份額提升，持續實現優於 WFE 的營收成長。

Q：毛利率短期展望及中長期改善空間？

A： 公司表示，CY3Q26 毛利率達 52.4%，創歷史新高，CY4Q26 毛利率指引進一步提高至 52.5%（±1ppt），儘管部分客戶組合變化可能帶來不利影響，整體獲利能力仍可維持穩健。管理層預

免責聲明：本文非研究報告，係由富邦證券法人業務處整理提供，所載資料僅供定客戶參考，不構成要約、招攬、宣傳、誘使等表示，亦無建議或推薦本文提及之任何證券，有關觀點亦未考量個別投資人之投資目標，富邦證券法人業務處不對投資損益負擔任何責任。

期，未來數個季度毛利率將大致維持在目前水準附近波動，短期尚未預期出現大幅跳升，但中長期仍維持毛利率朝 55% 左右 (mid-50s) 提升的目標。主要改善動能包括三項：首先，新產品導入將持續優化產品組合，尤其 Akara Etch 與 Aether Dry Resist 等具備高度技術差異化的產品，預期可隨客戶採用率及出貨規模提升，逐步改善整體獲利結構；其次，公司持續推動 Close-to-Customer 製造策略，透過將製造據點設置於更接近客戶晶圓廠的位置，降低物流及供應鏈成本，並改善製造效率，相關措施目前仍具備進一步優化空間；最後，公司持續執行產品定價調整，透過技術價值與產品差異化改善價格結構。管理層強調，上述新產品組合、製造效率及定價措施已共同推升 CY3Q26 毛利率至歷史高點，未來亦將持續作為毛利率擴張的主要驅動因素。整體而言，短期毛利率預計維持約 52%–53% 附近，中長期則有機會隨新產品放量、營運效率改善及價格優化，逐步朝 55% 左右的目標邁進。

Q：2026 年 WFE 持續上修的原因，以及 2027 年 WFE 是否具備進一步上行空間？

A： 公司表示，2026 年全球晶圓製造設備 (WFE) 市場規模預測已由年初約 US$135bn，逐步上修至超過 US$140bn、US$150bn，最新預估進一步提高至約 US$155bn，主要原因並非半導體製造商突然大幅改變長期資本支出計畫，而是客戶在既有無塵室空間限制下，持續尋找提高設備安裝密度及加快產能建置速度的方法，進而使實際設備投資規模高於年初預期。管理層指出，2026 年 WFE 預測逐季上修，主要反映晶圓製造商成功提高既有無塵室空間利用效率，並將部分原先規劃較晚執行的擴產專案提前，進而增加當年度可實際安裝及投入生產的設備數量。設備供應商同樣透過調整製造與交付安排，加速滿足客戶需求，因此即使整體半導體產業持續面臨無塵室空間限制，2026 年實際設備投資仍能不斷提高。展望 2027 年，公司目前預估全球 WFE 市場規模將超過 US$200bn，代表相較 2026 年約 US$155bn 的基礎，市場規模將成長接近 30% 或以上。管理層強調，US$200bn 以上僅為公司目前對 2027 年市場規模的初步預測，並非已確定的全年最終投資金額。由於公司通常不會在年度如此早期的階段提供下一年度 WFE

免責聲明：本文非研究報告，係由富邦證券法人業務處整理提供，所載資料僅供定客戶參考，不構成要約、招攬、宣傳、誘使等表示，亦無建議或推薦本文提及之任何證券，有關觀點亦未考量個別投資人之投資目標，富邦證券法人業務處不對投資損益負擔任何責任。

的具體數字，因此本次提前揭露超過 US$200bn 的預測，主要反映公司對未來設備需求具有高度信心。至於 2027 年是否可能再次出現類似 2026 年的持續上修情況，管理層並未提供明確幅度或承諾，但預計於下一季度法說會進一步更新市場預測，屆時將能根據客戶無塵室建置進度、供應鏈產能及設備交付能力，提供更精確的 WFE 展望。整體而言，2026 年 WFE 持續上修的核心因素在於既有產能限制逐步獲得緩解，而 2027 年能否進一步超越目前預測，仍取決於新增產能能否如期到位，以及半導體設備供應鏈能否有效支援快速成長的需求。

Q：加速股票回購計畫的規模、執行時間及股東回饋政策？

A：已於 CY3Q26 啟動加速股票回購（Accelerated Share Repurchase，ASR）計畫，主要目的為持續執行既定資本配置及股東回饋政策。相較一般公開市場股票回購，ASR 通常可使公司於交易初期先取得部分股份，後續再依照股票價格、波動程度及相關交易條件，於一定期間內逐步完成剩餘股份交割。管理層指出，由於 ASR 實際執行期間受到股價及市場波動等因素影響，因此公司不會揭露具體開始與結束日期，也不會公開相關交易安排的詳細條件，以避免市場參與者過度掌握公司的股票回購策略。公司確認，現有 ASR 計畫將持續於 CY4Q26 執行，並可能搭配其他公開市場股票回購方式，持續落實資本回饋政策。值得注意的是，公司截至 CY3Q26 底，董事會授權的股票回購額度尚餘約 US$3bn，但管理層並未揭露目前 ASR 計畫所占的具體金額，也未說明剩餘授權額度將於何時使用完畢。公司強調，中長期資本配置政策維持不變，目標仍為將約 85% 自由現金流量（Free Cash Flow）返還股東。整體而言，公司將持續透過股票回購及股利發放執行股東回饋政策，但短期回購規模、ASR 執行速度及具體交易安排，仍將視市場條件及公司資本配置需求彈性調整。

Q：面板級封裝產業發展進度及公司設備競爭優勢？

A： 公司表示，面板級封裝（Panel-Level Packaging，PLP）仍處於產業發展非常早期的階段，目

免責聲明：本文非研究報告，係由富邦證券法人業務處整理提供，所載資料僅供定客戶參考，不構成要約、招攬、宣傳、誘使等表示，亦無建議或推薦本文提及之任何證券，有關觀點亦未考量個別投資人之投資目標，富邦證券法人業務處不對投資損益負擔任何責任。

前晶圓級封裝（Wafer-Level Packaging，WLP）仍為半導體產業最主要的先進封裝方式，但隨著 AI 及高效能運算晶片的封裝尺寸持續增加，部分新世代封裝架構已逐漸接近甚至超過傳統晶圓級封裝所能有效支援的尺寸範圍，因此產業開始評估採用更大面積的面板作為封裝製造基礎。管理層認為，面板級封裝的長期發展具有合理性，主要原因在於 AI 系統整合規模持續擴大，晶片封裝不再僅涉及單一運算晶片，而是需要整合更多運算晶粒、記憶體及相關元件，使封裝面積逐漸增加。公司早在數年前便已觀察到相關趨勢，並持續投入面板級封裝設備研發及客戶驗證。根據管理層說明，公司目前已向全球超過 20 家客戶出貨面板相關設備，顯示公司已建立相當廣泛的客戶接觸基礎，但管理層亦強調，現階段相關設備出貨主要屬於產業早期布局，尚不代表面板級封裝已進入大規模量產階段。就設備技術而言，面板級封裝與現有晶圓級封裝具有部分相似製程需求，尤其電鍍（Plating）技術仍為重要製程之一，但面板級封裝所使用的設備與傳統 SABRE 平台並非完全相同，因此不能直接將現有晶圓級封裝設備名稱或規格套用至面板級封裝。公司認為，隨著面板級封裝逐步擴大應用，電鍍及其他相關製程設備均有機會受惠，且公司過去數年累積的設備研發、客戶合作及製程經驗，有助於建立長期競爭優勢。整體而言，管理層對面板級封裝長期市場滲透率提升保持樂觀，認為相關技術未來有機會承擔半導體產業相當比例的封裝工作，但目前尚未提供面板級封裝大規模量產時間、產業滲透率或具體營收貢獻預測。

Q：2027 年 DRAM 與先進邏輯設備需求成長差距是否縮小？

A： 公司表示，2027 年全球 WFE 市場規模預期超過 US$200bn，若依不同半導體終端市場的設備投資成長率排序，仍維持 DRAM 成長最快，其次為先進晶圓代工與邏輯製程（Foundry Logic），最後為 NAND 的預測，與約三個月前的產業展望相比並無明顯改變。雖然近期市場陸續出現多項先進邏輯晶圓廠擴產及新建廠計畫的公開消息，但管理層強調，相關投資計畫通常在正式對外公布之前，設備供應商便已透過客戶合作及長期產能規劃掌握相關資訊，因此近期公布的先進邏輯擴產專案並未顯著改變公司原先對 2027 年不同終端市場的設備需求預測。針對 DRAM

免責聲明：本文非研究報告，係由富邦證券法人業務處整理提供，所載資料僅供定客戶參考，不構成要約、招攬、宣傳、誘使等表示，亦無建議或推薦本文提及之任何證券，有關觀點亦未考量個別投資人之投資目標，富邦證券法人業務處不對投資損益負擔任何責任。

與 Foundry Logic 的成長差距是否因先進邏輯投資增加而縮小，公司明確表示，目前尚未觀察到明顯變化，DRAM 仍預期為 2027 年設備投資成長率最高的主要市場。值得注意的是，管理層並未進一步量化 DRAM、Foundry Logic 與 NAND 各自的 WFE 成長率，也未提供三大市場設備投資金額的具體差距，因此目前僅能確認公司維持原有的相對成長排序，而不能據此推算各市場的實際資本支出金額。

Q：2027 年 WFE 上下修的關鍵因素及無塵室產能瓶頸？

A： 公司表示，2027 年全球 WFE 市場規模能否進一步成長，除了半導體客戶的實際設備投資需求之外，更重要的因素在於無塵室建置時程、設備供應鏈產能，以及新建晶圓廠的人力與設備安裝能力能否同步到位。管理層指出，2027 年預計將有約 10 座新的 Tier-1 晶圓廠陸續投入運作，相關新增無塵室空間將於全年不同時間點逐步開出，成為支撐 2027 年 WFE 成長的重要基礎。相較之下，2026 年設備投資的主要限制來自既有無塵室空間不足，導致部分客戶即使具備新增設備需求，仍必須等待新廠建置完成，或透過提高既有廠房空間利用效率，才能增加設備安裝數量。進入 2027 年後，隨著新建晶圓廠陸續完工，無塵室空間限制有望逐步改善，但管理層亦指出，部分半導體設備零組件供應鏈已開始出現新的產能緊張情況，因此整體產業能否有效將新增無塵室空間轉換為實際設備投資，仍取決於設備製造商能否如期供貨。此外，新廠投產亦需要完成設備安裝、人員招募及員工訓練，任何一項執行進度延後，都可能影響實際設備支出認列時程。公司強調，目前對半導體設備需求的能見度已延伸至 2028 年，代表客戶長期設備採購需求相對明確，但需求能見度並不等同於設備可立即交付，實際 WFE 規模仍受到供給端執行能力限制。管理層預計於下一季度法說會進一步更新 2027 年 WFE 預測，屆時將能更準確掌握新建晶圓廠無塵室完工進度、設備供應鏈瓶頸及客戶實際擴產時程。整體而言，公司認為 2027 年 WFE 的主要不確定性並非終端需求不足，而是整體半導體產業能否有效協調新廠建置、設備交付及人力配置，進而將強勁需求轉化為實際設備支出。

免責聲明：本文非研究報告，係由富邦證券法人業務處整理提供，所載資料僅供定客戶參考，不構成要約、招攬、宣傳、誘使等表示，亦無建議或推薦本文提及之任何證券，有關觀點亦未考量個別投資人之投資目標，富邦證券法人業務處不對投資損益負擔任何責任。

Q：若無供應鏈及無塵室限制，2027 年實際 WFE 需求可能達到多少？

A： 公司表示，目前提出的 2027 年全球 WFE 超過 US$200bn 預測，已考量半導體產業實際面臨的無塵室空間不足、設備供應鏈產能限制，以及新建晶圓廠設備安裝進度等因素，因此相關數字反映的是在現有產業供給條件下，預期能夠實現的設備投資規模，而非完全不受限制的終端設備需求。管理層明確指出，若全球半導體產業不存在無塵室及設備供應鏈瓶頸，2027 年實際 WFE 需求將高於目前超過 US$200bn 的預測，顯示半導體製造商潛在設備採購需求仍高於產業短期可交付的設備規模。然而，公司並未量化不受供給限制情況下的潛在 WFE 金額，也未提供供需缺口的具體百分比。管理層強調，預期 2027 年仍將持續受到無塵室建置進度及部分供應鏈產能限制，因此即使終端需求強勁，實際設備支出仍須配合產業供給能力逐步實現。公司預計於下一季度法說會進一步更新 2027 年 WFE 預測，並根據新增無塵室空間、供應商擴產及客戶設備安裝進度，提供更具體的市場規模判斷。整體而言，公司確認 2027 年半導體設備市場仍存在未被完全滿足的需求，但目前尚無足夠資訊將潛在需求轉換為具體 WFE 金額。

Q：NAND 營收成長主要來自新設備或既有設備升級？

A： 公司表示，CY3Q26 NAND 系統設備營收季增約 40%，主要受惠於 NAND 製造商持續推進製程轉換與設備投資，而相關需求同時包含既有設備升級（Upgrades）及新設備採購（New Equipment），因此不能將 NAND 營收成長完全歸因於既有設備升級。管理層指出，NAND 製造商由較低堆疊層數轉向更高層數的製程架構時，除了透過升級既有設備提升製程能力之外，亦需要額外採購新設備，以支援新增製程步驟及更複雜的製造需求。由於既有設備升級通常反映於 Customer Support Business Group（CSBG）相關業務，而新設備銷售則反映於系統設備營收，因此 NAND 系統營收大幅成長，並不代表 CSBG 營收必須出現相同幅度的成長。針對 CY3Q26 NAND 系統設備營收顯著增加，但 CSBG 營收季增幅相對有限的情況，管理層確認，NAND 製程轉換確實同時帶動設備升級及新設備需求，但未進一步說明 CSBG 其他業務項目的營收變動

免責聲明：本文非研究報告，係由富邦證券法人業務處整理提供，所載資料僅供定客戶參考，不構成要約、招攬、宣傳、誘使等表示，亦無建議或推薦本文提及之任何證券，有關觀點亦未考量個別投資人之投資目標，富邦證券法人業務處不對投資損益負擔任何責任。

是否抵銷升級業務的成長。當市場進一步詢問新設備採購金額是否高於既有設備升級時，公司表示兩項業務均為 NAND 成長的重要貢獻來源，但未提供具體金額或相對比重。整體而言，NAND 製程轉換並非單純透過升級既有設備即可完成，隨著堆疊層數增加及製程架構複雜化，相關需求將同時反映於新設備銷售及設備升級業務，有利於公司擴大 NAND 設備相關營收機會。

Q：SLC NAND 需求是否已由概念轉向實際客戶規劃？

A： 公司表示，SLC Class NAND 作為 AI 儲存架構中的新興應用方向，已開始受到半導體客戶及產業參與者討論，但目前仍處於需求逐漸形成的階段，尚未提供明確的大規模量產或市場滲透率預測。管理層指出，隨著 AI 工作負載持續增加，市場已逐步認知到不同應用需要不同的記憶體及儲存效能，因此未來儲存架構可能不再單純以容量及成本作為主要設計依據，而是依據不同工作負載對頻寬、延遲及儲存容量的要求，採用不同類型的 NAND 產品。SLC Class NAND 被視為滿足低延遲 NAND 存取需求的潛在方案之一，而 High-Bandwidth Flash（HBF）等新型儲存架構亦已在產業中受到討論。公司認為，NAND 產業正由過去相對單一的儲存用途，逐步朝向依不同效能需求進行產品差異化的方向發展，相關變化將對 NAND 製程技術及晶圓產能需求產生影響。值得注意的是，公司特別強調，SLC NAND 對設備產業的重要性不僅在於新增製程技術需求，更在於 SLC 相較 TLC 的位元密度較低，因此當部分 NAND 位元需求轉向 SLC 架構時，即使整體儲存位元需求維持不變，半導體製造商仍需要增加晶圓產能，才能維持相同的位元供給。公司於法說會中指出，每當 NAND 位元需求組合有 1 個百分點轉向 SLC Class NAND，約需增加 2% 的晶圓產能，顯示新型儲存架構可能成為未來 NAND 設備需求的額外驅動因素。整體而言，管理層已觀察到客戶及產業對 SLC NAND 的關注增加，但尚未確認具體採用比例、量產時程或相關設備訂單規模，因此目前主要將 SLC NAND 視為具備潛力的新增成長機會。

免責聲明：本文非研究報告，係由富邦證券法人業務處整理提供，所載資料僅供定客戶參考，不構成要約、招攬、宣傳、誘使等表示，亦無建議或推薦本文提及之任何證券，有關觀點亦未考量個別投資人之投資目標，富邦證券法人業務處不對投資損益負擔任何責任。

Q：先進封裝業務於 2026–2027 年的成長預期？

A： 公司表示，維持 2026 年先進封裝相關業務營收成長約 70% 的預期，與前次法說會提出的展望一致，顯示先進封裝設備需求持續維持強勁，且目前尚未觀察到足以改變全年成長預測的重大因素。管理層指出，先進封裝已成為公司重要的成長領域，相關需求主要受惠於 AI 及高效能運算晶片持續提高封裝複雜度，帶動更多蝕刻、薄膜沉積及其他相關製程設備的應用機會。隨著先進邏輯晶片及高頻寬記憶體逐步採用更複雜的封裝架構，公司於相關製程中的設備需求亦有機會持續增加。展望 2027 年，管理層對先進封裝業務持續成長保持高度信心，並明確表示，若先進封裝相關業務未能於 2027 年繼續實現良好成長，將與公司目前觀察到的產業需求趨勢明顯不符。然而，公司尚未提供 2027 年先進封裝營收成長率的具體預測，也未揭露先進封裝在 2027 年超過 US$200bn WFE 市場中的預期占比。因此，目前可確認的量化指引為 2026 年先進封裝業務成長約 70%，而 2027 年則維持正面成長展望，但尚無明確的成長率目標。整體而言，管理層認為先進封裝設備需求將持續受惠於 AI 晶片架構演進及封裝複雜度提升，並成為公司未來數年的重要成長動能。

Q：Foundry Logic 每片晶圓 SAM 翻倍目標的進度及後續成長機會？

A：公司表示，2025 年 Investor Day 提出的 Foundry Logic 每片晶圓可服務市場(Served Available Market，SAM) 提升至原先兩倍的目標，主要建立在跨越多個先進製程世代的長期技術演進，而非單純由 3nm 轉換至 2nm 即可完成，因此不應將相關成長目標直接視為單一製程節點的設備需求增幅。管理層指出，若以當時提出的長期技術路線圖衡量，目前進展可能約達整體規劃的一半，但由於半導體製程持續出現新的設備應用機會，因此實際 SAM 擴張潛力亦可能隨技術演進進一步改變。首先，先進圖案化（Advanced Patterning）的重要性持續提升，隨著邏輯製程進一步微縮，晶片製造商對圖案精準度、製程穩定性及缺陷控制的要求同步提高，帶動公司 Aether Dry Resist 及 Akara Conductor Etch 等產品的需求增加。其次，背面供電(Backside Power Delivery)

免責聲明：本文非研究報告，係由富邦證券法人業務處整理提供，所載資料僅供定客戶參考，不構成要約、招攬、宣傳、誘使等表示，亦無建議或推薦本文提及之任何證券，有關觀點亦未考量個別投資人之投資目標，富邦證券法人業務處不對投資損益負擔任何責任。

正成為先進邏輯製程的重要技術方向，由於相關架構需要新增背面金屬化、蝕刻及薄膜沉積等製程，因此具備高度蝕刻與沉積設備使用強度，有利於擴大公司於先進邏輯製程的設備市場機會。此外，先進封裝在 Foundry Logic 製程中的重要性持續提高，相關技術已逐漸成為高效能運算晶片製造的重要環節，進一步增加公司可參與的設備製程範圍。管理層亦特別強調，公司於 Gate-All-Around（GAA）電晶體架構的技術布局，包括原子層沉積（ALD）及表面處理（Surface Treatment）等領域，已開始展現強勁的客戶採用動能，其中部分表面處理設備的實際市場接受程度甚至優於公司在 2025 年 Investor Day 時的原先預期。整體而言，公司認為 Foundry Logic 的成長機會已由單純的製程微縮，擴展至先進圖案化、背面供電、GAA 電晶體及先進封裝等多項技術轉換，且相關製程對蝕刻與薄膜沉積設備的依賴程度持續提高，因此有利於公司擴大每片晶圓 SAM，並透過新產品導入及既有技術優勢提高設備市場參與程度。不過，管理層尚未提供 3nm 至 2nm、或後續更先進製程節點的具體 SAM 增幅，也未量化各製程世代可能帶來的市占率提升幅度。

Q：Hybrid Bonding 導入對公司先進封裝業務的影響？

A： 公司表示，Hybrid Bonding（混合鍵合）為先進封裝技術發展的重要方向之一，隨著 AI 及高效能運算晶片對封裝密度、晶粒互連及系統整合能力的要求持續提高，相關技術有望成為未來先進封裝的重要製程。公司雖然並未直接提供 Hybrid Bonding 所使用的鍵合設備，但可透過薄膜沉積及蝕刻製程參與相關供應鏈，尤其在介電材料（Dielectric）與金屬材料（Metal）薄膜製備方面，相關製程品質對最終鍵合效果具有重要影響。管理層指出，Hybrid Bonding 必須透過多項製程技術整合才能達成理想的鍵合品質，而公司具備薄膜沉積與蝕刻領域的技術優勢，因此即使不直接參與鍵合步驟，仍可透過提供關鍵製程設備受惠於相關技術滲透率提升。值得注意的是，管理層並不認為 Hybrid Bonding 導入將削弱公司在先進封裝市場的競爭優勢，反而認為無論客戶最終選擇 Hybrid Bonding 或其他先進封裝架構，只要相關技術能夠提高先進封裝的

免責聲明：本文非研究報告，係由富邦證券法人業務處整理提供，所載資料僅供定客戶參考，不構成要約、招攬、宣傳、誘使等表示，亦無建議或推薦本文提及之任何證券，有關觀點亦未考量個別投資人之投資目標，富邦證券法人業務處不對投資損益負擔任何責任。

採用率，均有利於擴大公司設備的潛在需求。主要原因在於先進封裝相較其他半導體製造環節，具有較高的蝕刻及薄膜沉積製程強度，而公司目前已於先進封裝相關設備市場建立相當高的市占率，因此整體先進封裝市場規模擴大，有望進一步帶動公司設備營收成長。管理層強調，Hybrid Bonding 並非公司先進封裝成長策略的唯一技術方向，真正重要的是先進封裝整體技術滲透率及製程複雜度持續提高。整體而言，公司認為 Hybrid Bonding 的普及將帶來新增設備應用機會，且不會因為公司未直接提供鍵合設備而失去相關成長動能，但目前尚未量化 Hybrid Bonding 對公司先進封裝設備營收或市占率的具體貢獻。

Q：2027 年 SLC NAND 滲透率是否可能達到 5%？

A：目前判斷 2027 年 SLC Class NAND 的實際市場滲透率仍為時過早，相關產品的採用速度與市場規模主要取決於 NAND 製造商的產品規劃及終端客戶對不同儲存效能的需求，因此現階段無法提供具體的 SLC NAND 市場占比預測。針對市場提出 2027 年 SLC NAND 滲透率是否可能達到 5% 的假設，管理層指出此類產品組合及產能配置的預測，更適合由 NAND 製造商自行說明。儘管如此，公司對 SLC NAND 及其他新型儲存架構帶來的設備需求保持正面看法，主要原因在於不同儲存產品對製程結構及晶圓產能的要求存在差異，隨著 NAND 產品逐漸由傳統高密度儲存，轉向依據 AI 工作負載提供差異化效能，相關製程強度及設備需求亦有機會同步提升。管理層於法說會中指出，若 NAND 位元需求組合有 1 個百分點轉向 SLC Class NAND，在維持相同位元供給的情況下，約需增加 2% 的晶圓產能，顯示即使 SLC NAND 的實際市場滲透率仍有待確認，相關產品架構轉換仍可能對 NAND 晶圓產能需求產生顯著影響。此外，公司強調，無論最終採用 SLC NAND 或 High-Bandwidth Flash（HBF）等新型儲存架構，相關產品在製造過程中的設備使用強度均有機會提高，進而擴大公司可參與的設備市場。整體而言，管理層尚未對 2027 年 SLC NAND 滲透率提供量化預測，但確認相關技術轉換將提高 NAND 製造的設備製程強度，因此對公司中長期 NAND 設備需求具有正面意義。

免責聲明：本文非研究報告，係由富邦證券法人業務處整理提供，所載資料僅供定客戶參考，不構成要約、招攬、宣傳、誘使等表示，亦無建議或推薦本文提及之任何證券，有關觀點亦未考量個別投資人之投資目標，富邦證券法人業務處不對投資損益負擔任何責任。

Q：先進封裝相關金屬化及清洗製程的 SAM 規模？

A： 公司表示，隨著先進封裝技術持續演進，金屬化（Metallization）、預清洗（Pre-clean）及其他相關製程均可能帶來新增設備需求，但目前尚未完成足以對外揭露的市場規模評估，因此無法提供相關技術對公司可服務市場（SAM）的具體貢獻金額。管理層指出，先進封裝已成為公司重要的成長領域，而隨著封裝架構逐漸複雜化，相關製程需要整合更多材料處理、薄膜沉積及蝕刻步驟，因此公司具備參與新增製程需求的機會。針對市場希望比照過去以每 100,000 片晶圓產能作為基礎，估算特定先進封裝技術可帶來多少設備投資金額的提問，公司表示相關分析仍需要進一步研究，目前尚未準備好提供具體數字。管理層並未確認每 100,000 片晶圓產能所對應的設備投資金額，也未揭露相關金屬化、預清洗及其他先進封裝製程的個別 SAM，因此目前無法據此推算相關技術對公司未來營收的潛在貢獻。值得注意的是，公司並未否定未來量化相關市場機會的可能性，而是表示將相關議題列為後續研究方向。整體而言，先進封裝新技術持續增加蝕刻與薄膜沉積設備的應用機會，但相關製程所對應的新增設備市場規模，目前仍缺乏公司正式提供的量化依據。

Q：存貨週轉率的合理水準及後續庫存規劃？

A： 公司表示，CY3Q26 存貨金額達 US$4.6bn，較前一季度增加約 US$274mn，主要反映公司為因應未來設備需求成長，持續提前建立必要的零組件及設備庫存。儘管存貨絕對金額增加，公司的存貨週轉率仍由前一季度的 3.0 次改善至 3.4 次，創下近七年來最高水準，顯示隨著營收規模擴大及營運效率提升，存貨使用效率持續改善。管理層指出，目前對 3.4 次的存貨週轉率水準感到滿意，並未認為現階段有必要進一步大幅降低庫存。主要原因在於公司正處於設備需求快速成長的階段，2027 年全球 WFE 市場規模預期超過 US$200bn，因此公司需要提前準備足夠的零組件及設備庫存，以支援未來出貨需求，避免供應鏈瓶頸限制營收成長。隨著公司營收規模持續擴大，部分營運效率改善有助於提高存貨週轉率，但另一方面，為因應未來需求而提前

免責聲明：本文非研究報告，係由富邦證券法人業務處整理提供，所載資料僅供定客戶參考，不構成要約、招攬、宣傳、誘使等表示，亦無建議或推薦本文提及之任何證券，有關觀點亦未考量個別投資人之投資目標，富邦證券法人業務處不對投資損益負擔任何責任。

建立庫存，亦可能抵銷部分週轉效率改善的效果。管理層強調，目前庫存管理的主要目標並非單純追求更高的週轉率，而是在營運效率及供應保障之間取得平衡，確保公司能夠有效滿足未來設備需求。公司未提供中長期存貨週轉率的具體目標，也未預測未來數季存貨金額的變化幅度。整體而言，公司目前庫存水準及週轉效率均處於管理層認為合理的範圍，未來將持續配合設備需求成長調整庫存配置，以支援 2027 年的營收擴張。

Q：Aether Dry Resist 營收展望上修 US$1bn 的驅動因素？

A： 公司表示，已將 Aether Dry Resist 相關業務至 2030 年底的累計營收預測上修至約 US$2.5bn，較先前預期增加約 US$1bn，主要反映新客戶採用增加，以及既有客戶量產規模持續擴大所帶來的設備需求成長。管理層指出，Aether Dry Resist 的成長並非完全由新增客戶所驅動，而是新客戶導入及既有應用放量共同貢獻，其中高頻寬記憶體（HBM）製造需求快速成長，為推升相關設備需求的重要因素。隨著 Aether 技術逐步成為部分 HBM 製程的量產解決方案，相關客戶產能擴張將直接增加設備採購數量，使公司能夠隨終端產能成長持續擴大營收規模。管理層強調，Aether 目前已成功切入部分成長速度較快的半導體應用領域，因此即使不完全依賴新客戶數量增加，既有客戶的產能擴張仍可帶動相關業務持續成長。此外，Aether Dry Resist 具備支援先進圖案化的技術優勢，可滿足先進半導體製程對圖案精準度及製程效率的要求，因此公司對相關產品的長期應用機會保持正面看法。值得注意的是，管理層並未量化新增客戶與既有客戶產能擴張對 US$1bn 上修金額的個別貢獻，也未揭露各終端應用的營收占比，因此目前無法判斷新增客戶與既有客戶放量何者占據絕對多數。整體而言，Aether Dry Resist 累計營收預測上修主要反映產品已進入實際量產應用，並受惠於 HBM 等高成長市場的產能擴張，使相關設備需求持續增加。公司認為，隨著先進圖案化需求提高及既有客戶擴產，Aether 有望成為未來數年重要的新增營收來源。

免責聲明：本文非研究報告，係由富邦證券法人業務處整理提供，所載資料僅供定客戶參考，不構成要約、招攬、宣傳、誘使等表示，亦無建議或推薦本文提及之任何證券，有關觀點亦未考量個別投資人之投資目標，富邦證券法人業務處不對投資損益負擔任何責任。

公司近期新聞

1. Lam Research Corporation Announces September Quarter Financial Conference Call
2. Lam Research Announces Retirement of Michael R. Cannon and Sohail U. Ahmed from Board of Directors
3. Lam Research Corporation Announces a 27% Increase in Quarterly Dividend

免責聲明：本文非研究報告，係由富邦證券法人業務處整理提供，所載資料僅供定客戶參考，不構成要約、招攬、宣傳、誘使等表示，亦無建議或推薦本文提及之任何證券，有關觀點亦未考量個別投資人之投資目標，富邦證券法人業務處不對投資損益負擔任何責任。

近期投行報告觀點

公司為 AI 資料中心、高頻寬記憶體(HBM)及先進邏輯製程擴產的重要設備供應商，受惠先進製程與記憶體升級需求，公司未來數年營收成長動能持續增強。報告預期 2026 至 2028 年營收及獲利將維持高雙位數成長，毛利率與營業利益率亦有望隨產品組合改善而持續提升。隨著 DRAM、HBM 及先進封裝投資擴大，公司在蝕刻與沉積設備領域的競爭優勢可望進一步受惠。此外，強勁現金流與持續執行庫藏股計畫，有助提升股東報酬。

所持看好理由：

- AI 伺服器與 HBM 擴產帶動先進半導體設備需求成長。
- 產品組合改善推升毛利率與營業利益率持續向上。
- 營運現金流強勁，具備穩定回購股票與提高股東報酬能力。

提醒留意風險：

- 記憶體及晶圓代工資本支出若低於預期，恐影響設備需求。
- 中國市場需求與出口管制政策變化仍具不確定性。
- 半導體景氣循環波動可能影響訂單與獲利表現。

免責聲明：本文非研究報告，係由富邦證券法人業務處整理提供，所載資料僅供定客戶參考，不構成要約、招攬、宣傳、誘使等表示，亦無建議或推薦本文提及之任何證券，有關觀點亦未考量個別投資人之投資目標，富邦證券法人業務處不對投資損益負擔任何責任。

主要研究機構分析師評等

券商名稱	分析師	評等	目標價	日期
Bernstein	Stacy Rasgon	outperform	385	2026/10/21
Evercore ISI	Mark Lipacis	outperform	315	2026/10/20
Aletheia Capital Limitec	Warren Lau	buy	400	2026/10/20
Deutsche Bank	Melissa Weathers	buy	375	2026/10/19
Stifel	Brian Chin	buy	425	2026/10/19
TD Cowen	Krish Sankar	buy	400	2026/10/16
Wells Fargo	Joe Quatrochi	overweight	355	2026/10/15
Morgan Stanley	Shane Brett	Overwt/In-Line	385	2026/10/5
Citi	Atif Malik	buy	450	2026/9/9
JP Morgan	Harlan Sur	overweight	340	2026/7/30
HSBC	Adithya Metuku	hold	325	2026/7/30
Jefferies	Blayne Curtis	buy	335	2026/7/29
Oppenheimer	Edward Yang	outperform	400	2026/7/29
Susquehanna	Mehdi Hosseini	Positive	475	2026/7/29
Barclays	Tom O'Malley	equalweight	335	2026/7/29
Goldman Sachs	James Schneider	buy	380	2026/7/5

◆ 內法業務二科（海外股）02-27725938 | Head of Sales– 楊佩瑾 Peichin ext. 61808 peichin.yang@fubon.com

邱宗煜 Alvin ext. 61651 alvin.chiu@fubon.com
石容榕 Doris ext. 61807 doris.jj.shih@fubon.com
王能偉 Shawn ext. 61637 shawn.nw.wang@fubon.com
賴柔璇 Angie ext. 61833 angie.lai@fubon.com
吳侑軒 Kevin ext. 61640 hsuan.y.wu@fubon.com
郭洹妁 Chloe ext. 61874 chloe.yc.kuo@fubon.com

免責聲明：本文非研究報告，係由富邦證券法人業務處整理提供，所載資料僅供定客戶參考，不構成要約、招攬、宣傳、誘使等表示，亦無建議或推薦本文提及之任何證券，有關觀點亦未考量個別投資人之投資目標，富邦證券法人業務處不對投資損益負擔任何責任。